

## Маломощный импульсный диод

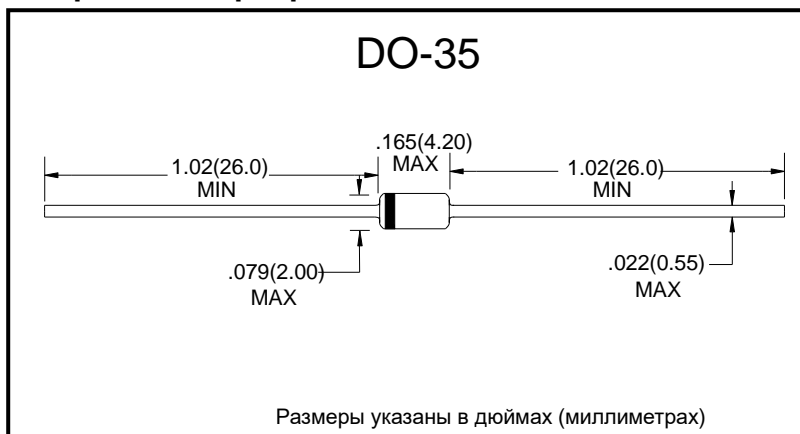
### ■ Особенности

- $V_R$  75 В
- $I_{FAV}$  150 мА

### ■ Применение

- Сверхбыстрое переключение

### ■ Габариты и маркировка



### ■ Максимально допустимые значения

Характеристика	Обозначение	Ед. изм.	Условия	Максимум
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$V_{RRM}$	В		100
Обратное напряжение	$V_R$	В		75
Ударный прямой ток	$I_{FSM}$	А	$t_p=1$ мкс	2
Повторяющийся импульсный прямой ток	$I_{FRM}$	мА		500
Постоянный прямой ток	$I_F$	мА		300
Средний прямой ток	$I_{FAV}$	мА	$V_R=0$	150
Мощность рассеивания	$P_{tot}$	мВт	$L=4$ мм, $T_L=45^\circ\text{C}$	440
			$L=4$ мм, $T_L\leq 25^\circ\text{C}$	500
Тепловое сопротивление	$R_{thJA}$	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	Между кристаллом и окр. средой, $L=4$ мм, $T_L=\text{constant}$	350
Максимальная допустимая температура	$T_j$	$^\circ\text{C}$		175
Диапазон температуры хранения	$T_{stg}$	$^\circ\text{C}$		От -65 до +175

**■ Электрические характеристики (T<sub>a</sub>=25°C, если иное не указано в спецификации)**

Характеристика	Обозначение	Ед. изм.	Условия	Максимум
Прямое напряжение	V <sub>F</sub>	мВ	I <sub>F</sub> =200 мА	1000
Обратный ток	I <sub>R</sub>	нА	V <sub>R</sub> =20 В	25
	I <sub>R</sub>	мкА	V <sub>R</sub> =20 В, T <sub>J</sub> =150°C	50
	I <sub>R</sub>	мкА	V <sub>R</sub> =75 В	5
Пробивное напряжение диода	V <sub>(BR)</sub>	В	I <sub>R</sub> =100 мкА, t <sub>p</sub> /T=0.01, t <sub>p</sub> =0.3 мс	100(min)
Емкость перехода	C <sub>D</sub>	пФ	V <sub>R</sub> =0, f = 1 МГц, V <sub>HF</sub> =50 мВ	4
Время восстановления обратного сопротивления	t <sub>rr</sub>	нс	I <sub>F</sub> = I <sub>R</sub> =10 мА, i <sub>R</sub> =1 мА	8
	t <sub>rr</sub>	нс	I <sub>F</sub> = 10 мА, V <sub>R</sub> =6 В, i <sub>R</sub> =0.1×I <sub>R</sub> , R <sub>L</sub> =100 Ом	4

**■ Характеристики(Типовые)**
